

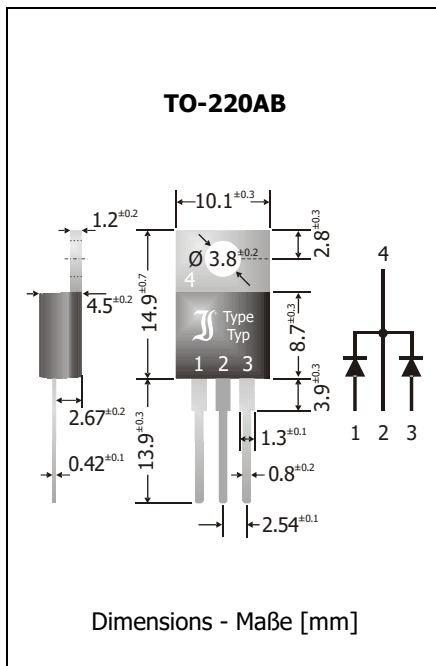
30CTQ200

High Temperature Schottky Rectifier Diodes
Hochtemperatur-Schottky-Gleichrichterdiodes

$I_{FAV} = 2 \times 15 \text{ A}$
 $V_{F1} \sim 0.72 \text{ V}$
 $T_{jmax} = 175^\circ\text{C}$

$V_{RRM} = 200 \text{ V}$
 $I_{FSM} = 225/250 \text{ A}$

Version 2017-09-18

**Typical Applications**

High Frequent Output Rectification in DC/DC Converters, Polarity Protection, Free-wheeling diodes Commercial grade ¹⁾

Typische Anwendungen

Hochfrequenz-Ausgangsgleichrichtung in Gleichstromwandlern, Verpolschutz, Freilaufdiodes Standardausführung ¹⁾

Features

High temperature operation
 High reverse voltage
 Dual diodes with common cathode
 Low forward voltage drop
 Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals ¹⁾

**Besonderheiten**

Hochtemperatur-Einsatz
 Hohe Sperrspannung
 Doppeldioden mit gemeinsamer Kathode
 Niedrige Fluss-Spannung
 Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Packed in tubes/cardboards 50/1000
 Weight approx. 2.2 g
 Case material UL 94V-0
 Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL = 1

Mechanische Daten ¹⁾

Verpackt in Stangen/Kartons
 Gewicht ca. Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ³⁾**

| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] |
|-------------|--|---|
| 30CTQ200 | 200 | 200 |

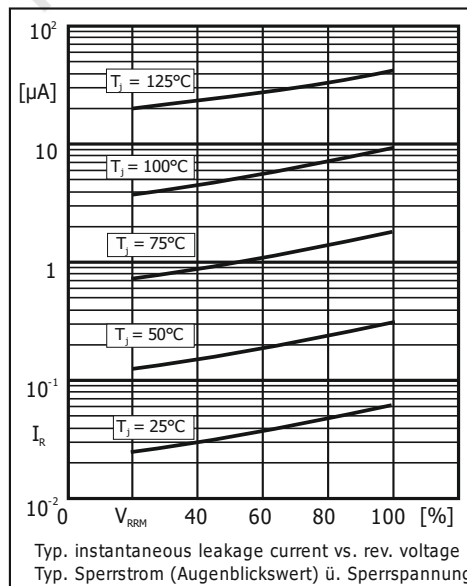
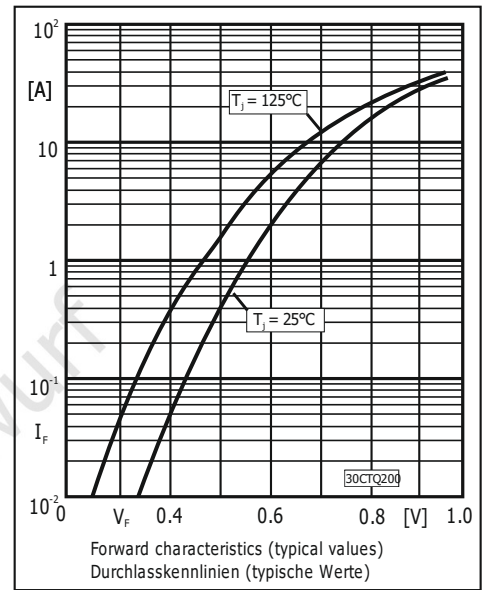
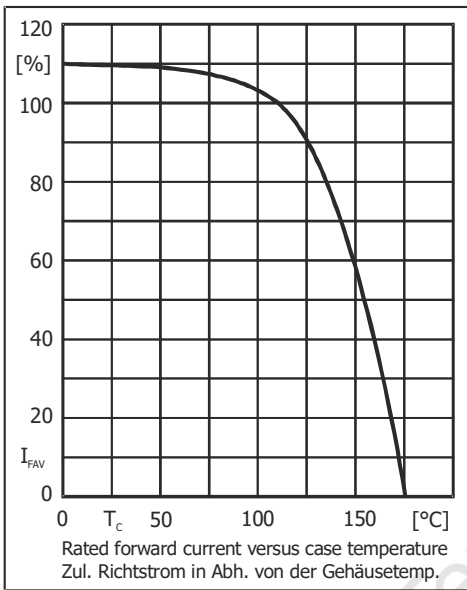
| | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom in Einwegschaltung | $T_C = 110^\circ\text{C}$ | I_{FAV} | 15 A ³⁾ 30 A ⁴⁾ | |
| Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom | $f > 15 \text{ Hz}$ | $T_C = 110^\circ\text{C}$ | I_{FRM} | 53 A ³⁾ |
| Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung | half sine-wave Sinus-Halbwellen | 50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms) | I_{FSM} | 225 A 250 A |
| Rating for fusing Grenzlastintegral | $t < 10 \text{ ms}$ | i^2t | | 80 A ² s |
| Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur | | T_j T_j | | -50...+175°C -50...+150°C |

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ wenn nicht anders angegeben
- Per diode – Pro Diode
- Per device (parallel operation) – Pro Bauteil (Parallelbetrieb)

Characteristics ¹⁾

Kennwerte ¹⁾

| Type Typ | Forward voltage Durchlass-Spannung | | | Forward voltage Durchlass-Spannung | | |
|--|---|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | V _F [V] | @ I _F [A] | @ T _j | V _F [V] | @ I _F [A] | @ T _j |
| 30CTQ200 | typ 0.72 | 15 | 125°C | < 0.86 | 15 | 25°C |
| Leakage current Sperrstrom | T _j = 25°C T _j = 125°C | | | V _R = V _{RRM} | I _R | < 50 µA typ. 1 mA |
| Typical junction capacitance – Typische Sperrschichtkapazität | | | | V _R = 4 V | C _j | 220 pF |
| Thermal resistance junction to case – Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse | | | | | R _{thc} | < 3 K/W ²⁾ |



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Per diode – Pro Diode
2 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne